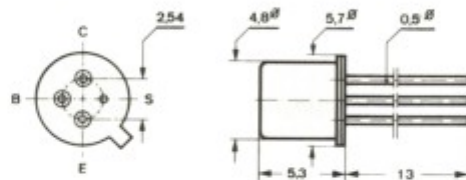


2 N 918**Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor für UHF-Verstärker und Oszillatoren.**

Silicon NPN epitaxial planar transistor for UHF amplifiers and oscillators.

Abmessungen · DimensionsMaße in mm
M 2:1Kollektor mit Gehäuse verbunden
Collector is connected to caseNormgehäuse
DIN 18 A 4
JEDEC TO 72
Gewicht · Weight
max. 0,5 g**Zubehör · Accessories**

Zwischensockel Ident-Nr. 009 010

Absolute Grenzdaten · Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung	U_{CB0}	30	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	U_{CE0}	15	V
Emitter-Basis-Sperrspannung	U_{EB0}	3	V
Gesamtverlustleistung			
$t_{amb} \leq 25^{\circ}C$	P_{tot}	200	mW
$t_{case} \leq 25^{\circ}C$	P_{tot}	300	mW
Sperrschichttemperatur	t_j	200	$^{\circ}C$
Lagerungstemperatur	t_{stg}	-65... + 200	$^{\circ}C$



2 N 918

Wärmewiderstände · Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung	R_{thJA}	≤ 880	$^{\circ}C/W$
Sperrschicht-Gehäuse	R_{thJC}	≤ 585	$^{\circ}C/W$

Statische Kenngrößen · DC characteristics

Umgebungstemperatur $t_{amb} = 25^{\circ}C$, falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.
Kollektorreststrom				
$U_{CB} = 15 V$	$I_{CBO}^{*})$			10 nA
$U_{CB} = 15 V, t_{amb} = 150^{\circ}C$	$I_{CBO}^{**})$			1 μA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung	$U_{(BR)CBO}^{*})$	30		V
$I_C = 1 \mu A$				
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung	$U_{(BR)CEO}^{*}) 1)$	15		V
$I_C = 3 mA$				
Emitter-Basis-Durchbruchspannung	$U_{(BR)EBO}^{*})$	3		V
$I_B = 10 \mu A$				
Kollektor-Sättigungsspannung	U_{CEsat}			0,4 V
$I_C = 10 mA, I_B = 1 mA$				
Basis-Sättigungsspannung	U_{BEsat}			1 V
$I_C = 10 mA, I_B = 1 mA$				
Kollektor-Basis-Gleichstromverhältnis	h_{FE}	20		
$U_{CE} = 1 V, I_C = 3 mA$				

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%

1) impulsmäßig gemessen: $\frac{t_D}{T} = 0,02, t_p = \leq 0,3 ms$

